



## ウツタル・プラデーシュ州半導体政策 2024

ウツタル プラデーシュ州政府 IT 電子電子局

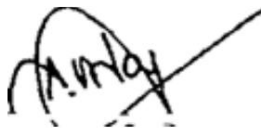
# DISTINATION UTTAR PRADESH

Invest in BIDA



# コンテンツ

前文...	3
方針のビジョンと目的.....	4
ビジョン.....	4
2.2 ポリシーの目的.....	4
ガバナンス.....	4
3.1 ノードエージェンシー.....	4
3.2 ポリシー実行ユニット (PIU) .....	5
3.3 権限を与えられた委員会 (EC).....	5
ポリシーの実施と適用範囲.....	5 4.1 保険期間と補償範
囲.....	5
4.2 適格基準.....	5
4.3 利用規約.....	6
5. 承認と支出.....	7
5.1承認プロセス.....	7
5.2補助金の支給 .....	7
6. インセンティブ.....	7
6.1 財政的インセンティブ .....	7
6.2 非財政的インセンティブ.....	9
7申請の流れ.....	11 8.用語
集 .....	12
9略語.....	16

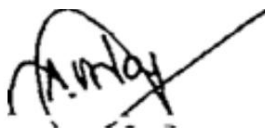


## 1前文

半導体製造は、業界全体の現代の進歩にとって極めて重要です。スマートフォン、コンピュータ、医療機器などのデバイスの効率を高めます。また、AI、IoT、量子コンピューティングの革新も促進します。経済的には、複雑なサプライチェーンを通じて雇用の創出と成長を促進するとともに、投資により技術主権と世界競争力が確保されます。このデジタル時代において、半導体はイノベーションを推進します。つながり、そして繁栄。

インド半導体ミッションは、インドを世界的な半導体プレーヤーとして確立することを目指しています。この使命は、現地生産、R&D、輸入依存の削減に焦点を当て、イノベーションと高度な雇用機会を促進します。この取り組みは、インフラを改善し、コラボレーションを可能にし、熟練した労働者を育成することにより、インドの技術的自主性と半導体とエレクトロニクス分野での世界的地位を向上させます。これは、デジタルの卓越性と世界の半導体情勢への多大な貢献に対するインドの願望と一致しています。

インド政府のビジョンに沿って、国内 GDP の約 9% を占める急速に成長する経済成長を遂げているウッタラ プラデーシュ州は、州内の半導体エコシステムの育成に専念しています。この取り組みはエレクトロニクス製造とイノベーションの拡大を加速する態勢が整っています。これは、1 兆ドル (USD) 経済を目指すという国の野望と調和しており、インドを 5 兆ドル (USD) 経済に押し上げるという首相の包括的な目標とも一致しています。

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anil', with a long horizontal line extending to the right.

## 方針のビジョンと目的

---

### 2.1 ビジョン

熟練した人材を効果的に活用し、イノベーションと新興技術を適応させ、総合的な持続可能な生産につながる半導体製造をウツタル・プラデーシュ州の重要な成長原動力として育成するための世界的に競争力のあるインフラと有利な政策環境を提供し、ウツタル・プラデーシュ州を半導体産業の好ましい目的地として確立する。これにより、エコシステムが州および国家の経済全体の成長に貢献します。

### 2.2 ポリシーの目的

ウツタル プラデーシュ州半導体製造政策の主な目的は次のとおりです。

- ウツタル・プラデーシュ州に強固な半導体製造エコシステムを確立し、経済成長を推進し、イノベーションを促進し、実質的な雇用機会を創出し、戦略的に重要な分野でインドの自主性を強化する態勢を整える。
- 先進的な設計およびテストツールを備えた最先端のインフラストラクチャを開発し、スタートアップ間の共同作業を促進します。企業や教育機関の可能性を最大限に引き出します。
- 州内での支援的なファブレスエコシステムの育成に重点を置く  
チップ設計企業と新興企業をターゲットにすることについて。
- 産学間の強力なつながりを確立し、  
カリキュラムの強化、エレクトロニクス教育の定期的な更新、州のスキル開発ミッションを通じた主要なスキル構築ワークショップの促進を通じて、熟練した人材プールを育成します。
- 半導体設計および製造プロセスにおけるより高い付加価値を重視しながら、中長期的に潜在的な製造ユニットの設立に役立つ環境への道を切り開く。

## 3. ガバナンス

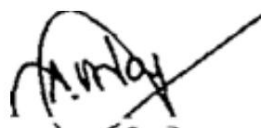
### 3.1 ノードエージェンシー

UP Electronics Corporation Limited は、その部門の下にあるノード代理店です  
IT・エレクトロニクス部門、政府ウツタルプラデーシュ州の州知事が責任を負います。  
ウツタル・プラデーシュ州半導体政策2024の効果的な実施。

同庁は、州内の半導体エコシステムの持続的な成長に役立つ政策環境を作り出す責任を負う。それはミルします

すべてのエコシステム関係者と関わるための単一の窓口として機能します。シングル ウィンドウの運用を管理するために、Nodal Agency は専用の窓口を設置します。

プロジェクト管理ユニット (PMU) には、政府をサポートするために外部委託された専門家やコンサルタントが適切に配置されています。



### 3.2 ポリシー実行ユニット (PIU)

首席書記長/追加首席書記長の議長の下にある PIU。 Hoda\ Agencyの業務を監督するために、IT & エレクトロニクス部門が設置されるものとします。 PIU は、権限委員会への勧告を含む、ポリシーの効果的な実施に責任を負います。 PIU は、投資提案を検討し、必要な承認を得るために権限委員委員会に推奨する責任を負います。

この委員会は、ACS/PS によって産業開発局、州税務局、印紙および登録局、IT およびエレクトロニクスから指名されたメンバーで構成されます。財務、住宅局、労働局、および必要に応じて、他の部門/産業開発当局などのメンバーが含まれる場合があります。

### 3.3 権限を与えられた委員会 {EC}

政策の効果的な実施を監視するために、州長官が委員長を務める州レベルの権限を有する委員会が設置されるものとする。委員会の憲章は、政策の効果的な実施と、あらゆるレベルでの投資家の問題のタイムリーな解決に関する部門間の調整に関するものとする。この方針に基づいて申請されるすべてのプロジェクトは、権限委員会の再勧告について閣僚の承認を受ける必要があります。

この委員会は、産業開発局、州税務局、IT およびエレクトロニクス、財務、計画、中小企業の ACS/PS で構成されます。商業税、エネルギー、灌漑、住宅局、労働局、および必要に応じて、追加の首席秘書官/他の部門の首席秘書官/産業開発庁の CEOなどが含まれる場合があります。

ポリシーに基づいて構成された権限委員会は、ポリシーの延長/修正を決定するものとします。

## 4. ポリシーの実施と適用範囲

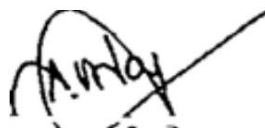
### 4.1 保険期間と補償範囲

UP-Semiconductor Policy 2024 は、通知日から 5 年間有効です。  
この政策は州全体を対象としています。投資は方針の通知日から許可されます。

この制度の恩恵を受ける事業者は、プロジェクト全体の商業生産の開始日から少なくとも 3 年間は商業生産活動を維持することを約束しなければならず、その旨の正式な誓約書を提出する必要があります。

### 4.2 適格基準

インド政府のインド半導体ミッション (ISM) の以下のスキームのいずれかに基づいて認定されたプロジェクトは、このポリシーに基づいて適格となります。



#### 4.1.1 インドにおける半導体工場設立スキーム

#### 4.1.2 インドにおけるディスプレイファブ設立スキーム

4.1.3 インドにおける化合物半導体 / シリコン フォトニクス センサー製造工場および半導体組立て、テスト、マーキング、およびパッケージング (ATMP)/OSAT 施設の設立計画。

4.1.4 法によって修正または提案されているその他の同様のスキーム  
インド政府。

4.1.5 デザインリンクインセンティブに基づいて承認されたプロジェクト、またはファブレス活動に関連するプロジェクトは、このポリシーでは対象となりませんが、投資家は UP IT/ITeS ポリシー 2022 に基づいて特典を申請し、利用することができます。

#### 4.2 適格な投資

4.2.1 半導体ファブ: プロジェクト費用の割合としての FiScdl サポートは、インド政府が発行したインドにおける半導体ファブの立ち上げのための修正スキームに関するガイドラインのセクション 2.12 で定義された活動に限定されます。2023 年 5 月 29 日、随時修正。(用語集8(ii))

4.2.2 ディスプレイファブ: プロジェクト費用の割合としての財政支援は、2023 年 5 月 29 日付インド政府メイティによるインドにおけるディスプレイファブ設置のための修正スキームに関するガイドラインのセクション 2.12 で定義された活動に限定されるものとします。時々修正されます。(用語集6(ii))

4.2.3 ATMP/OSAT: 資本支出に占める財政支援は制限されるものとする  
2023 年 6 月 30 日付のインド政府メイティによるインドにおける ATMP/OSAT 施設設置のための修正スキームに関するガイドライン (随時修正) のセクション 2.1.1 に基づいて定義された活動に適用されます。(用語集8(iii))

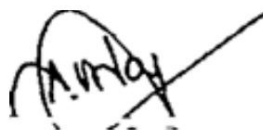
#### 利用規約

この政策は、州内の他の政策や制度と適合させることはできません。ただし、インド政府の計画/政策により、ダブテイルは許可されます。このポリシーで指定されているすべてのインセンティブは、インド政府のスキーム/政策に基づいて利用可能なインセンティブに加えて利用できます。政府が提供するインセンティブ/補助金には、インド政府が承認した対象プロジェクトの総費用の 100% という全体的な上限が適用されます。

さまざまな半導体関連施設を設置するための修正スキームに基づいて提案されたプロジェクトの事業費にすでに計上されている設備投資または投資。半導体タブを含む。ディスプレイ ファブ、化合物半導体/シリコン フォトニクス センサー ファブ、半導体アSEMBリ、テスト、マーキング、およびパッケージング (ATMP)。通知 CG-DL-E-04 102022-239339 da(ed 04 .

2022 年 10 月、CG-DL-E-06102022-239340

2022 年 4 月 10 日付けの政策および 2023 年 9 月 6 日付けの CG-DL-E-10062023-246449 は資本補助金のみの対象となり、政策に概要が記載されているその他の給付金は受けられません。





## 4. 承認と支出

### 4.1 承認プロセス:

半導体ハブ、ディスプレイ製造、化合物半導体を含む取り組みに対して提出された提案書。シリコンフォトニクス (SiPh)、センサー (MEMS含む) Fab. インドのディスクリート半導体ファブ、および半導体組立、テスト、マーキング、およびパッケージング (ATMP) / 外部委託半導体組立およびテスト (OSAT) 施設は、インド半導体ミッション (ISM) インド政府によって承認されており、ウッタルプラデーシュ州内で捜査が行われた場合は、州内閣の承認を得るために送られることになる。国家内閣の承認は、権限委員会の勧告に基づいて行われます。

- GoUP による承認プロセス: インド政府のインド半導体ミッションによって承認された提案。半導体施設の設定を検討している (ウッタルプラデーシュ州の4.2.1、4.2.8および4.2.3jに定義されているように、承認されたインセンティブが適格プロジェクト合計の100%を超えないという条件を条件としてLOCが与えられる) ISM によって承認されたコストと発行された LoC は、インド政府による提案の承認後にのみ有効になります。

- 申請者は UP-Semiconductor Policy 2024 に基づいて同時に申請する必要があります。  
インド半導体ミッションに提案を提出しながら

### 4.2 補助金の交付

インド政府によって提供されるものに追加される資本的インセンティブ。インド政府が投資家にシェアを解放した場合にのみ支払いが行われ、支払いはパリパスモードで行われます。

その他すべての財政的インセンティブ。資本補助金とは別に、方針に規定されている土地代のリベート、印紙税および登録料の免除は、商業生産の開始時に受けられるものとします。

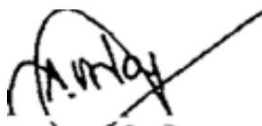
## 6 インセンティブ

この政策に基づいて提供される金銭的インセンティブは、インド政府が提供するインセンティブをはるかに上回っています。ただし、ポリシーに別段の記載がない限り、ユニットが請求するインセンティブは、インド政府によって与えられたインセンティブを含むすべての情報源から取得されます。適格プロジェクト費用の 100 円を超えてはなりません (本ポリシーの第 4.3 項で定義)。

### 6.1 財政的インセンティブ

6.1.1 資本補助金: GOI が承認した資本補助金 50 年。この給付金は、インド政府がパリパス方式で提供する給付金に基づいて支払われます。

6.1.2 利子補助金: 指定銀行/金融機関から得た融資に対して、200 クルルピーまでの投資を行うユニットに対して、年間 5% (金利に基づく) の利子補助金が、最大 1 ルピールピーまで返済されます。7 年間、ユニットあたり年間(ユニットあたり最大 INR 7 Cr)



D. 補助金は、プロジェクトの承認時に 50 分の 1 に分割して提供され、承認から 3 年後に次の 25%、5 年以内に約束した成果の達成時に最後の 25% が提供されます。

### 6.1.1 センター オブ エクセレンス (CoE):

この政策では、半導体分野の研究とイノベーションを促進するために、センター オブ エクセレンス (CoE) の形で世界クラスのインフラを構築することを想定しています。ポリシーは、評判の高い学術機関および/または業界団体/業界、またはその他の政府/民間団体と協力してセンター・オブ・エクセレンスを設立することを目的としています。CoE プロジェクトの総費用のうち最大 505 ドル (最大 10 Cr の対象) が UP 政府によって負担されます。

企業は第 6.1.9 項または第 6.1.10 項のうち 1 つのオプションのみを検討する必要があります。それは、研究開発センターまたはセントラル オブ エクセレンスの設立に関する補助金を利用できるかのどちらかです。

### 6.1.2 特許登録料の払い戻し:

特許登録料は、国内特許の取得については最大 10 万ルピー、国際特許の一括取得については最大 20 万ルピーの対象となる経費の 75% の割合で払い戻されます。

### 6.1.3 工業用住宅:

ユニットの敷地から半径 10 km 以内の労働者の住宅/寮および関連集合施設の開発費の 10 パーセントまたは 10 億ルピーのいずれか低い方を、年 7 回の均等分割で提供します。

## 6.2 非財政的インセンティブ

6.2.1 ミッションクリティカルなインフラストラクチャ: 州内の半導体産業は、必須サービスおよびメンテナンス法 (ESMA) の下で必須サービスプロバイダーとして分類されます。

6.2.2 給水: 州政府プロジェクトサイトの半導体ユニットへの給水を確保します。

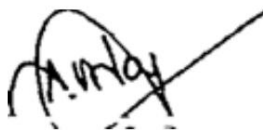
6.2.3 ユニットのオープンアクセスを通じて電力を取得できるものとします。

6.2.4 再生可能/グリーン エネルギー用のパワー バンキングはユニットに提供され、(州の電力規制委員会 ERC ガイドラインに従って管理されます)。

6.2.5

6.2.6 政府は、FAB プロジェクトのシームレスな運営のための信頼できる電力供給を保証するために、送電網に十分な冗長性を確保する。

6.2.6 混乱防止条項: 確実な事業継続を提供するため。開発者が投資を完了し、それぞれの当局から完了証明書を取得し、リース料を全額支払った場合、当該当局の半導体ユニットによる違反があった場合には、当局の承認がリース契約を解除するための前提条件となります。規範/細則。



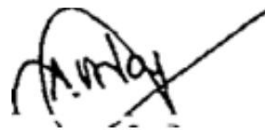


6.2.7 3 交代勤務: 半導体部門は、女性従業員の安全とセキュリティに関して必要な予防措置を講じることを条件として、24 時間 365 日の操業と 3 交代勤務すべてでの女性の雇用が許可されるものとしします。

6.2.8 自己認証: 半導体ユニットは、特定の苦情に起因する検査を除き、以下の法律およびそれに基づく規則に基づく検査から免除されます。これらのユニットは、所定の形式で自己証明書を提出することが許可されています。

- 工場法 • 出産手当法 • 店舗法

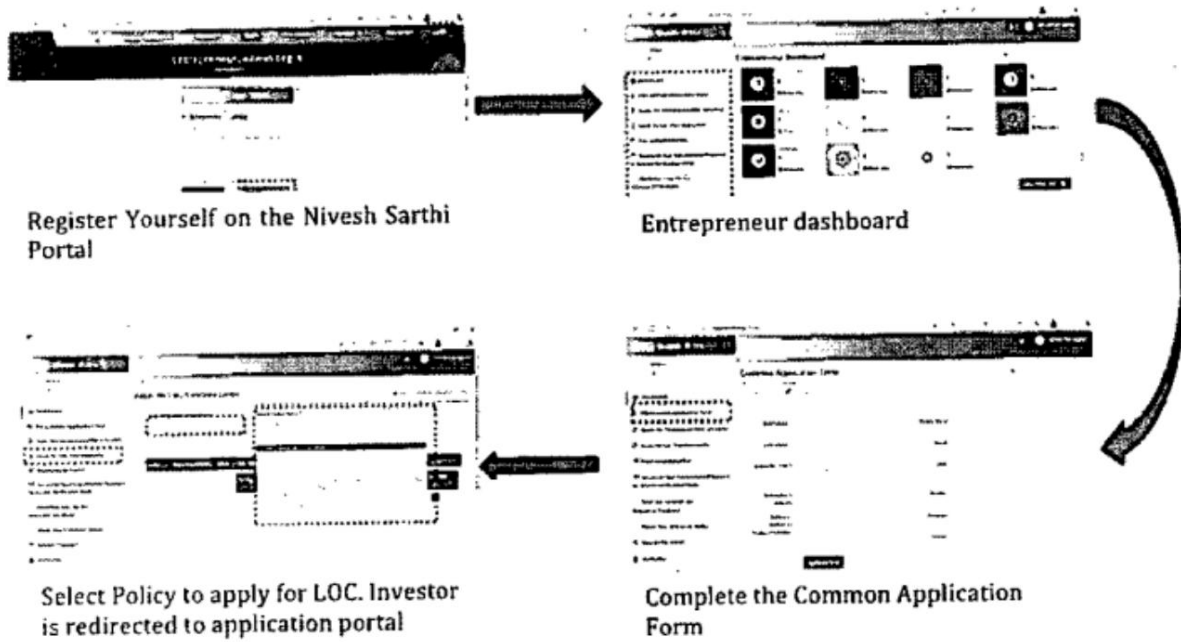
- 契約労働（規制・廃止）法 • 賃金支払法 • 最低賃金法

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. J.', with a long horizontal line extending to the right.

## 7. 申請の流れ

ウツタル プラデーシュ州のシングル ウィンドウ ポータル (<https://niveshmifra.up.nic.in/>) である Nivesh Mitra は、ビジネス プロセスを簡素化するオールインワンのオンライン プラットフォームです。これにより、オンライン申請、書類のアップロード、手数料の支払い、ライブステータスの追跡、デジタル署名された NOC が可能になります。ウツタルプラデーシュ州で事業を開始および運営するために必要な、設立前、運営前、更新、および追加の証明書のための必須の認可、ライセンス、LOC および NOC の発行を処理します。

申請者は、Nivesh Mitra ポータルを使用して提案を提出する必要があります。その後、オンライン インセンティブ管理システムに誘導されます。ここでは、UP-Semiconductor Policy 2024 に基づいて IT およびエレクトロニクス部門からの慰安状 (LOC) を申請するために、プロジェクトに関連する重要な提案の詳細と文書を提出する必要があります。



*(Handwritten signature)*

## 8. 用語集

半導体製造: さまざまな電子製品に使用される半導体デバイスを作成するプロセス。

私。半導体およびディスプレイ工場設立のための適格資本投資: 半導体工場設立のための修正スキームに関するガイドライン (告示番号 CG-DL-E-06102022-239339) および半導体ファブ設立のための修正スキームに関するガイドラインのセクション 2.12 に記載されているとおりです。ディスプレイファブ (届出番号 CG-DL-E-06102022-239340) ファイルNo.

W-38/21/2022/PHW 日付 2022 年 5 月 29 日

プロジェクトコストには資本支出/投資が含まれます。

- 土地、建物、プラント、機械、クリーンルーム、設備。および関連ユーティリティ

- 研究開発技術移転

- 建設中の利息などのその他の関連費用  
保険料

iii. 化合物半導体 / シリコン フォトニクス / センサー ファブ / ディスクリート半導体ファブおよび半導体 ATMP および OSAT の設立のための適格資本投資: 化合物半導体 / シリコン フォトニクス / センサー ファブ / ディスクリートの設立のための修正スキームに関するガイドラインのセクション 2.11 に記載されている通りインドの半導体製造工場および半導体組立、テスト、マーキングおよびパッケージング (ATMP)/外部委託半導体組立およびテスト (OSAT) 施設 (以下、「スキーム」といいます) は、通知番号 CG-OL-E-06102022- を参照して通知されています。 239341 (2022 年 4 月 10 日修正) 通知番号 CG-DL-E-10062023- を参照

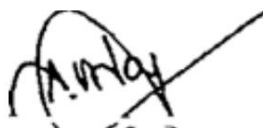
246449 日付 09.06.2023、ファイル番号 W-38/21/2022/IPHW 日付 2023.06.30

- 建物、プラント、機械に発生する設備投資/投資。クリーン

- 部屋、設備、および関連するユーティリティ

- 研究および研究のために発生した設備投資 / 投資  
開発者( (研究開発)

- 設備投資・技術移転に係る投資  
(ToT) 協定



・プロジェクト/ユニットに必要な土地に発生した支出は、スキームに基づく適格な資本支出/投資の計算には考慮されません。

インド半導体ミッション (ISM): インド半導体ミッション iv.

インド政府電子情報技術省 (MeitY) Digital India Corporation 内の (ISM) は、半導体およびディスプレイ製造エコシステムの開発のためのプログラム/修正プログラムの実施の結節点です。

で。 Nodal Agency: の監督を担当する主要な政府機関。

ウットラルプラデーシュ州における半導体政策の実施。

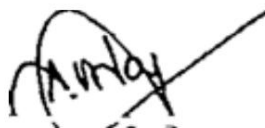
vi.政策実施ユニット (PIU): 首席秘書官/追加首席秘書官が議長を務める専門部署。 IT & エレクトロニクス部門。Nodal Agency の業務を監督します。

vii.権限委員会 (EC): 長官が委員長を務める国家レベルの委員会で、政策実施の監視と部門間の調整を担当します。

iii.インドの半導体工場向けの修正スキームは、電子情報技術省 (Meit YN,2022 年 10 月 4 日、官報通知番号 CG-DL-E-04102022-239339) によって通知されました。

修正されたスキームは、インドでの半導体工場設立のためのプロジェクト費用のSOAの財政支援を提供する。プロジェクトのコストには、土地、建物、プラント、機械、設備、および関連する光熱費が含まれます。財政支援は、申請の承認後、制度ガイドラインと承認書に規定されている条件に従って、パリパスベースで提供されます。

ix.インドのディスプレイ工場向けの修正スキームは、2022 年 10 月 4 日に電子情報技術省 (tMeit Y) により、官報通知番号 CG-DL-E-04102022-239340 を通じて通知されました。修正されたスキームでは、インドでのディスプレイ工場の設立に対するプロジェクト費用の 50 グラムの財政支援が提供されます。プロジェクトの費用には、土地、建物、工場、機械、設備、および関連する費用が含まれます。



ユーティリティ。財政支援は、申請の承認後、制度ガイドラインと承認書に規定されている条件に従って、パリパスベースで提供されます。

バツ。インドの化合物半導体および ATMP 施設に関する修正スキームは、2022 年 10 月 4 日に電子情報技術省 (MeitY) により、官報通知番号 CG DL-E-06102022-239341 を通じて通知されました。インドの化合物半導体および ATMP 施設向けの修正スキームにより、化合物半導体/シリコンフォトニクス/センサー工場/個別半導体工場および半導体組立て、テスト、マーキング、パッケージング(ATMPJ/外部委託半導体)の設立のための資本支出の50ドルの財政支援が提供されました。インドの組立およびテスト (OSAT) 施設。

化合物半導体: 周期表の異なる族の 2 つ以上の元素から形成される半導体材料。

ディスプレイ製造: 電子機器に使用されるディスプレイを製造するプロセス

デバイス。

ファブレス エコシステム: 社内製造施設を持たない半導体チップの設計と開発に焦点を当てたエコシステム。

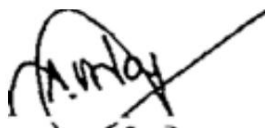
Letter of Comfort (LoC): 発行者が義務を履行するという保証を当事者に提供するために使用される金融商品。

15.パリパス: Nodal Agency による比例配分は、申請者/プロジェクト会社が他の企業とともに動員する対応するシェアの後に解放されます。

十六.妨害防止条項: ポリシー違反によるリースのキャンセルについて取締役会の承認を必要とすることで、事業の継続性を確保する条項。

17. Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility: 半導体のパッケージングおよびテスト サービスを提供する施設。

18.半導体製造 (FAB): 半導体デバイスを作成するプロセス。半導体製造とも呼ばれます。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. M. Jay', with a long horizontal line extending to the right.

19.半導体フォトンクス: 情報処理と伝送のための光子 (光粒子) の使用に関連する半導体技術の分野。

××。経済特別区 (SEZ): 投資を誘致し、輸出を促進するために、ビジネスおよび貿易法が国内の他の地域とは異なる指定地域。

XXi Capital 補助金: 半導体製造プロジェクトで発生する資本コストを削減するために政府が提供する財政援助。

xxii 印紙税: 法的文書、特に土地の購入または賃貸に関連する文書に課される税。

xxiii.電力補助金: 半導体製造部門の電気代を削減する金銭的インセンティブ。

xxiv.電気税: 電気の消費に対する税。

xxv.デュアル パワー グリッド ネットワーク: 半導体工場の無停電電源を確保するための冗長電源インフラストラクチャ。

二十六.送電および託送料金: 電力の送電および配電に関連するコスト。

xxvii.必須セキュリティおよびメンテナンス法 fESMA7: 特定の機能を指定する法律

産業やサービスを不可欠なものとして扱い、それらの中断のない運営を保証します。

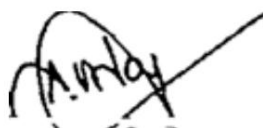
XXVii.オープンアクセス: ユニットが送電網または他のプロバイダーから直接電力を購入できる機能。

xxix.パワーバンキング: 余剰の再生可能エネルギーを貯蔵し、必要なときに使用する機能。

xxx.ケースバイケース: 特定の状況に基づいて個別に決定されます。

×××。自己認証: 外部の検査を必要とせずに、部門が特定の労働法の遵守を宣言できるプロセス。

xxxii.銀行/金融機関: 予定されているすべての銀行が考慮されます。インド準備銀行によって規制および承認されているすべての金融機関が考慮されます。





## 9. 略語

- アル - 人工知能
- ATMP - 組み立て、テスト、マーキング、梱包
- EC - 権限を与えられた委員会
- EMC - 電子機器製造クラスター
- ESDM - 電子システム設計 & 製造
- FCI - 固定資本投資
- GOI - インド政府
- IoT - モノのインターネット
- IT - 情報技術
- ISM - インド半導体ミッション
- MeitY - 電子情報技術省
- OSAT - 外部委託組立テスト
- PIU - プロジェクト実施ユニット
- PMU - プロジェクト管理ユニット
- SEZ - 特別経済区

### 免責事項この「ウ

「ウッタラ プラデーシュ州半導体政策 2024 年」文書は、ヒンディー語以外のユーザーを容易にし、より広範囲にリーチできるようにするために、純粹にオリジナルのヒンディー語から翻訳されています。翻訳の正確性を確保するために最大限の注意が払われていますが、ここに規定されている条項の解釈に相違がある場合には、官報に掲載された「オリジナル」のヒンディー語版が優先されます。

